



SiCパワーデバイス開発エンジニア [54151]

ルネサス エレクトロニクス株式会社での募集です。 商品企画・商品開発（技術系）...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

ルネサス エレクトロニクス株式会社

Job ID

1488883

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Ehime Prefecture

Salary

5 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:15

Holidays

【有給休暇】初年度 23日 1か月目から 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 夏季休暇 年末年始 【有給休暇】入社月に付与 (...)

Refreshed

January 31st, 2025 04:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2181716】

【職務内容】

- パワーデバイス・プロセス開発
 - ・構想検討から量産技術確立までのウエハプロセス開発エンジニア
 - ・デバイス構造設計やウエハプロセスフロー構築
 - ・要素プロセス技術（ウエハプロセス、裏面プロセス）、製品設計、品質保証など多部門との連携

【魅力】

ルネサスは「人々の暮らしを楽（ラク）にする」技術で持続可能な将来を築いていく日本を代表する半導体企業です。自動

運転やIoTなど多様な分野において、先進的な製品やソリューションを提供しています。当社の製品は、世界中の主要な電子機器メーカーに採用され、日々の暮らしに欠かせない身の回りのあらゆる電子機器に使用されています。

当社では世界25カ国の製造・開発・販売拠点において20,000人以上の従業員が働いています。グローバルチームとして、すべての従業員が、行動指針である「Renesas Culture」をもとに、互いに学習、協力、成長、目標に向けて前進しながら、日々さまざまな課題解決に取り組んでいます。

当社を取り巻く環境は近年の活発な大型M Aを含めて、他に類を見ないほどダイナミックに動いています。今後もインフラやデータエコノミー関連の急成長市場でのシェア拡大や、産業/IoTや自動車分野でのプレゼンス強化を図ります。変化の激しい中、グローバルチームの一員として、私たちと一緒に持続可能な将来を築いていただける方をお待ちしています。

Required Skills

■Must要件

- ・半導体デバイス構造設計やプロセス開発経験 3年以上
(半導体物理の基礎知識、ウェハプロセス試作経験)

■Want要件

- ・パワーデバイス (IGBT パワーMOS (Si SiC) FRD) 開発経験
- ・TCADシミュレーションスキル
- ・TEGレイアウトスキル
- ・デバイス電気特性評価スキル
- ・海外との共同プロジェクト経験
- ・パワーエレクトロニクス全般の基礎知識

※上記Must・Want要件は担当～課長クラス共通の要件となります。

■期待する行動役割など (求める人物像)

パワーデバイス未経験の方でも当分野トップレベルのエンジニアとしてスキルアップに取り組める方

Company Description

各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売およびサービス